



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 23 卷 第 4 期 2002 年 4 月

目 次

研究快报

- Fabrication and Electrical Properties of Titanium Oxide by Thermally Oxidizing Titanium on Silicon
 Zhu Huiwen, Zhao Bairu, Liu Xiaoyan, Kang Jinfeng and Han Ruqi (337)
- A Single Mode 980nm InGaAs/GaAs/AlGaAs Large Optical Cavity Quantum Well Laser with Low Vertical Divergence Angle
 Zhu Xiaopeng, Xu Zuntu, Zhang Jingming, Ma Xiaoyu and Chen Lianghui (342)
- A High Speed IGBT Based on Dynamic Controlled Anode-Short
 Yang Hongqiang and Chen Xingbi (347)
- A Novel Lateral Solenoidal On-Chip Integrated Inductor Implemented in Conventional Si Process
 Liu Chang, Chen Xueliang, Yan Jinlong and Gu Weidong (352)
- A Novel CMOS Dual-Modulus Prescaler Based on New Optimized Structure and Dynamic Circuit Technique
 Chi Baoyong and Shi Bingxue (357)
- Precision Bulk Micromachining Based on KOH Anisotropic Etching Using Ultrasonic Agitation
 Chen Jing, Liu Litian, Li Zhijian, Tan Zhimin, Jiang Qianshao, Fang Huajun, Xu Yang and Liu Yanxiang (362)
- Effect of Neutral Traps on Tunneling Current and SILC in Ultrathin Oxide Layer
 Zhang Heqiu, Mao Lingfeng, Xu Mingzhen and Tan Changhua (367)

研究论文

- InGaAs 量子点的自发发射及光增益 宁永强 高欣 王立军 Peter Smowton Peter Blood (373)
- p 型微氮直拉硅中氧施主的电学特性 余学功 杨德仁 马向阳 汤艳 李东升 李立本 阙端麟 (377)
- 区熔硅近表面洁净区和体内微缺陷的形成 李传波 李怀祥 刘桂荣 郭成花 张华 薛成山 (382)
- 富氧氮氧化硅薄膜退火的研究 但亚平 岳瑞峰 王燕 姚永昭 徐杨 刘理天 (388)
- 高压热处理对氧沉淀低温形核的影响 徐进 杨德仁 马向阳 李春龙 阙端麟 A. Misiuk (394)
- 窄条宽 MOCVD 选区生长 InP 系材料的速率增强因子 张瑞英 董杰 周帆 冯志伟 边静 王圩 (399)
- 手机用砷化镓双刀双掷单片射频开关成品率分析
 李拂晓 蒋幼泉 吴振海 徐中仓 钮利荣 周剑明 邵凯 杨乃彬 (403)
- 表面态密度分布和源漏电阻对 6H-SiC PMOS 器件特性的影响 郜锦侠 张义门 张玉明 汤晓燕 (408)
- 多晶硅薄膜晶体管源漏轻掺杂结构的优化设计 李牧菊 杨柏梁 (414)
- 考虑量子力学效应的超薄栅氧 nMOSFET's 直接隧穿电流二维模型 陈立锋 马玉涛 田立林 (419)
- Au-AlGaN/GaN HFET 研制与器件特性 张锦文 闫桂珍 张太平 王玮 宁宝俊 武国英 (424)
- 低能电子束照射集成电路芯片时的静态电容衬度分析 冯仁剑 张海波 Katsumi URA (428)
- 硅在 KOH 中各向异性腐蚀的物理模型 姜岩峰 黄庆安 吴文刚 郝一龙 杨振川 (434)
- 基于 MATLAB 的硅各向异性腐蚀过程模拟 张佩君 黄庆安 (440)
- Ge 预非晶化硅化物工艺的研究 孙海锋 刘新宇 海潮和 徐秋霞 吴德馨 (445)